

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 前澤宏一 副委員長 津田邦男
幹事 松永高治・鈴木寿一 幹事補佐 新井 学・東脇正高

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦
幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

★レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (LQE)

専門委員長 小路 元 副委員長 野田 進
幹事 梅沢俊匡・藤原直樹

日時 11月26日(木) 10:30~17:20
27日(金) 10:00~16:15

会場 大阪市立大学学術情報センター会議室 (<https://www.media.osaka-cu.ac.jp>)

議題 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

26日午前

- RF 窒素プラズマを用いた表面窒化による α -(AlGa)₂O₃ 上 AlGa_xN 形成に関する検討
○荒木 努・武馬 輝・増田 直・名西やす之 (立命館大)・織田真也・人羅俊実 (FLOSFIA)
- 微傾斜角度の異なる c 面サファイア基板上への AlN 成長と N₂-CO アニール
○鈴木周平・林 家弘・三宅秀人・平松和政 (三重大)・福山博之 (東北大)
- AlN/Sapphire 基板を用いた RF 加熱式 HVPE による AlN 成長
○安井大貴・三宅秀人・平松和政 (三重大)・岩谷素顕・赤崎 勇 (名城大)・天野 浩 (名大)
- 酸性アモノサーマル法合成 GaN 種結晶上にハイドライド気相エピタキシャル成長させた m 面自立 GaN 基板の電気的・光学的特性
○小島一信 (東北大)・塚田悠介 (三菱化学)・古川えりか・斉藤 真 (東北大)・三川 豊・久保秀一・池田宏隆・藤戸健史 (三菱化学)・上殿明良 (筑波大)・秩父重英 (東北大)

26日午後 (13:10~)

- ホール効果測定による低濃度 Mg ドープ p 型 GaN の正孔キャリア密度及び移動度の解析
○堀田昌宏 (京大)・高島信也・田中 亮・上野勝典・江戸雅晴 (富士電機)・須田 淳 (京大)
- ホール効果測定によるホモエピタキシャル成長低 Si ドープ n 型 GaN の電気的特性評価
○澤田直暉 (京大)・成田哲生・加地 徹・上杉 勉 (豊田中研)・堀田昌宏・須田 淳 (京大)
- ホモエピタキシャル成長 n 型 Ni/GaN ショットキーダイオードの光電流の波長依存性
○前田拓也 (京大)・岡田政也・上野昌紀・山本喜之 (住友電工)・堀田昌宏・須田 淳 (京大)
- 1.6kV 大電流 GaN トレンチ型ジャンクションバリアダイオードの開発
○梶谷 亮・宇治田信二・半田浩之・柴田大輔・小川雅弘・田中健一郎・石田秀俊・田村聡之・石田昌宏・上田哲三 (パナソニック)
- [招待講演] AlN テンプレート上 Si 添加高 AlN モル分率 Al_xGa_{1-x}N 多重量子井戸の時間空間分解陰極線蛍光分光評価
○秩父重英 (東北大)・三宅秀人・平松和政 (三重大)
- 光音響・発光同時計測法及び時間分解発光計測による GaN の輻射・非輻射再結合寿命の測定
○河上航平・中納 隆・山口敦史 (金沢工大)
- 光音響・発光同時計測法を用いた GaN の内部量子効率の測定 ○中納 隆・河上航平・山口敦史 (金沢工大)
- 多波長励起発光分離法を用いた InGa_xN 薄膜のラマン散乱分光
○石戸亮祐・石井良太・船戸 充・川上養一 (京大)
- アルミニウムを用いたプラズモニクスの発光増強応用
○岡本晃一・立石和隆・川元 駿・西田知句・玉田 薫 (九大)・船戸 充・川上養一 (京大)

27日午前

- 伝導型の違いからみた GaN 中プラズマ照射誘起欠陥の挙動解明
○古賀祐介・中村成志・奥村次徳 (首都大東京)
- Temperature controlled atomic layer deposition of GaN using plasma-excited nitrogen source
○P. Pungboon Pansila・Kensaku Kanomata・Bashir Ahammad・Shigeru Kubota・Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.)
- Interface analysis of Ti/Al-based ohmic contact on AlGa_xN/GaN structure grown on GaN substrate
○Dariush H. Zadeh・Shinichi Tanabe・Noriyuki Watanabe・Hideaki Matsuzaki (NTT)

4. ALDにより成膜したHfO₂を用いたAlGa_N/Ga_N MIS-HEMTの界面準位とデバイス特性
○西野剛介・久保俊晴・江川孝志(名工大)
 5. Si基板上AlGa_N/Ga_N HEMT構造における縦方向リーク電流の初期Al_N層の依存性
○山岡優哉(大陽日酸)・伊藤和宏(名工大)・生方映徳・田淵俊也・松本 功(大陽日酸)・江川孝志(名工大)
- 27日午後(13:05~)
6. Ga_N系THz-QCLの最近の進展 ○寺嶋 亘・平山秀樹(理研)
 7. 無極性a面AlGa_N/Al_Nの高温成長と深紫外発光特性 ○定 昌史・平山秀樹(理研)
 8. m面サファイア上AlGa_N/Al_Nの結晶成長と光学特性
○大島一晟(埼玉大/理研)・定 昌史・前田哲利(理研)・鎌田憲彦(埼玉大)・平山秀樹(理研)
 9. 表面保護膜形成によるInGa_N系太陽電池の特性改善 ○加畑智基・堤 達哉・三好実人・江川孝志(名工大)
 10. スマートスタック技術による多接合太陽電池の接合界面の評価
○野中翔一郎・古川昭雄(東京理科大)・牧田紀久夫・水野英範・菅谷武芳・仁木 栄(産総研)
 11. GaAs/GaAs接合の電気特性に対するアニール効果 ○柴 麗・梁 剣波・重川直輝(阪市大)
 12. 表面活性化ボンディング法に依るSi/SiC接合の電気特性
○林 朋宏・梁 剣波(阪市大)・新井 学(新日本無線)・重川直輝(阪市大)

☆CPM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

12月1日(火)~3日(木) 長崎県勤労福祉会館〔締切済〕 テーマ:デザインガイア2015—VLSI設計の新しい大地—

☆LQE研究会今後の予定 []内発表申込締切日

12月18日(金) 機械振興会館〔締切済〕 テーマ:半導体レーザー関連技術及び一般

1月28日(木), 29日(金) 神戸市産業振興センター〔11月9日(月)〕 テーマ:フォトリックNW・デバイス,
フォトリック結晶, ファイバとその応用, 光集積回路, 光導波路素子, 光スイッチング, 導波路解析, マイクロ
波・ミリ波フォトリックス, 及び一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

梅沢俊匡(NICT)

TEL [042] 327-7528, FAX [042] 327-7938

E-mail: toshi_umezawa@nict.go.jp

藤原直樹(NTT)

TEL [046] 240-3266, FAX [046] 240-4345

E-mail: fujiwara.naoki@lab.ntt.co.jp

◎LQE研究会ホームページ

<http://www.ieice.org/~lqe/jpn/>

◎LQE研究会では平成18年度より「LQE奨励賞」を設けました。対象は発表年度の4月1日時点で32歳以下の若手研究者(学生を含む)です。積極的に御投稿下さい。